

第7回 実行委員長 梅本宏信(静岡大学)

2010年6月18日(金)～19日(土)

研究会：静岡大学浜松キャンパス 佐鳴会館会議室

第7回Cat-CVD研究会プログラム

6月18日(金)

13:30-13:35 オープニング(梅本宏信)

座長：松村英樹

13:35-14:10

マイクロ波CVDによる微結晶Si-TFT(依頼講演) 牛島満(東京エレクトロン)

14:10-14:45

オーロラPLD法による薄膜堆積(依頼講演)

○脇谷尚樹¹、坂元尚紀¹、鈴木久男¹、篠崎和夫²(¹静岡大学、²東京工業大学)

14:45-15:05

Coffee break

座長：大平圭介

15:05-15:40

色素増感太陽電池の将来展望(依頼講演) 昆野昭則(静岡大学)

15:40-15:55

太陽電池セル用酸化アルミニウムパッシベーション膜のCat-CVDによる作製

荻田陽一郎、○立原誠之、會澤洋太郎、齋藤直之(神奈川工科大学)

15:55-16:10

メッシュ状キャタライザーを用いたパルスモードCat-CVD法によるGaNの成長

永田一樹¹、里本宗一¹、齋藤健¹、片桐裕則²、神保和夫²、○安井寛治¹
(¹長岡技術科学大学、²長岡工業高等専門学校)

16:10-16:30

Coffee break

座長：天明二郎

16:30-17:20

高付加価値を実現するTFT技術(特別講演)

○波多野睦子¹、大倉理²

(¹日立製作所、²日立ディスプレイ)

座長：梅本宏信

17:20-18:10

一般市民に科学技術を語るには(特別講演)

由利伸子(サイテック・コミュニケーションズ)

19:00-21:00

懇親会（オークラアクトシティホテル45階 展望回廊）

6月19日（土）

座長：和泉亮

9:00-9:35

シリコン系太陽電池の現状と将来（依頼講演） 増田淳（産業技術総合研究所）

9:35-9:50

触媒反応で生じたP系ラジカルによるSi基板への低温ドーピング

○早川太朗、宮本素明、小山晃一、大平圭介、松村英樹（北陸先端科学技術大学院大学）

9:50-10:05

Cat-CVDを用いたSiNx/a-Si積層膜によるc-Siのパッシベーション

○小山晃一、大平圭介、松村英樹（北陸先端科学技術大学院大学）

10:05-10:20

HMDSを用いた $\mu\text{c-3C-SiC/a-SiC}$ 薄膜のHW-CVD成長

小川泰弘、野木努、宮坂悠太、○中村篤志、天明二郎（静岡大学）

10:20-10:40

Coffee break

座長：中山弘

10:40-11:15

HW-CVD（Cat-CVD）法によるナノ結晶3C-SiC:H薄膜の低温形成（依頼講演）

田畑彰守（名古屋大学）

11:15-11:30

カーボンナノウォール成長における基板表面ラフネスの効果

○藤井裕太、中西庸介、伊藤貴紀、伊藤翔平、伊藤貴司、野々村修一（岐阜大学）

11:30-11:45

Cat-CVD法により作製したCNWにおけるウォール形状の膜厚による変化

○伊藤翔平、藤井裕太、坂野充彦、中西庸介、伊藤貴司、野々村修一（岐阜大学）

11:45-12:00

架橋した化学増幅型フォトレジストSU-8の水素原子による分解メカニズム

○熊野勝文、田中秀治、江刺正喜（東北大学）

12:00-13:00

Lunch

座長：西山岩男

13:00-13:35

原子状水素とレジストとの非平衡反応へのアレニウス則の導入 (依頼講演)

山本雅史 (明電舎)

13:35-13:50

原子状水素を用いた SU-8 レジストの除去

○丸岡岳志、新井祐、山本雅史、後藤洋介、河野昭彦、堀邊英夫 (金沢工業大学)

13:50-14:05

Influence of Hydrogen Exposure in a Hot-wire System on Morphology and Electrical Property of Silver Lines

○Nguyen Thi Thanh Kieu, Keisuke Ohdaira, Tatsuya Shimoda, Hideki Matsumura (JAIST)

14:05-14:20

水素ラジカルを用いた酸化物除去によるフリップチップ接合状態の改善

○田畑浩二¹、中島毅¹、宮本幸司²、佐藤充弘²、野北寛太³、和泉亮¹

(¹九州工業大学、²長瀬産業、³北九州産業学術推進機構)

14:20-14:35

アンモニアラジカル処理を施した金属基板上に堆積した SiCN 膜の耐食性評価

○吉田佑太郎¹、中西洋行¹、原田力¹、緒方徹¹、川原淳樹¹、門谷豊^{1,2}、和泉亮^{1,2}

(¹九州工業大学、²トップマコート)

14:35-14:55

Coffee break

座長：中村篤志

14:55-15:30

ホットワイヤ (CAT) 法によるシリコン膜の水素化効果 (依頼講演)

○清水耕作、増田洋平、石橋大典 (日本大学)

15:30-15:45

SiCN を用いた超ガスバリアフィルムの開発とロールツーロール成膜の検討

○中山弘、伊藤道弘 (マテリアルデザインファクトリー)

15:45-16:00

SiCN の有機 Cat-CVD と物性評価

○中山弘^{1,2}、伊藤道弘¹、福田常男²

(¹マテリアルデザインファクトリー、²大阪市立大学)

16:00-16:15

N₂ の触媒分解による N 原子の生成

梅本宏信 (静岡大学)

16:15-16:30

Ru 触媒体上でのアンモニアの分解による H 原子および NH ラジカル生成機構

○梅本宏信¹、柏木雄大¹、大平圭介²、小林弘幸²、安井寛治³

(¹静岡大学、²北陸先端科学技術大学院大学、³長岡技術科学大学)

16:30-16:40

クロージング (天明二郎、次回実行委員長)